# 法政大学学術機関リポジトリ

## HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2025-07-16

## 高精度非接触電界計測のための直行型EOプ ローブに関する研究

### YABE, Yoko / 矢部, 陽子

(出版者 / Publisher)法政大学大学院理工学・工学研究科

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

法政大学大学院紀要.理工学・工学研究科編 / 法政大学大学院紀要.理工学・工 学研究科編

(巻 / Volume)
57
(開始ページ / Start Page)
1
(終了ページ / End Page)
4
(発行年 / Year)
2016-03-24
(URL)
https://doi.org/10.15002/00013293

## 高精度非接触電界計測のための 直行型 EO プローブに関する研究

#### A TRANSVERSE ELECTRO-OPTIC PROBE SYSTEM FOR NON-CONTACT MEASUREMENT OF ELECTRIC NEAR FIELDS

矢部陽子 Yoko YABE 指導教員 品川満

法政大学大学院理工学研究科応用情報工学専攻修士課程

An organic photovoltaic (OPV) device is a light and flexible solar battery and can be used in various situations. The OPV device is produced by using a roll-to-roll production process, and its performance can be estimated by measuring the electric near fields over it. We developed a non-contact type of electro-optic probe for measuring electric fields of OPV. It detects transverse electric near fields and has higher sensitivity. *Key Words* :*electro-optic probe, pockels effect, electric near field detection* 

#### 1. 序論

OPV(:Organic Photovoltaic device)は太陽電池の1種であ る.フィルム状で薄い,軽い,柔らかい,安価といった特 徴を持ち,roll-to-roll と呼ばれる製造方法で大量生産され る[1].ロール状基盤の上に有機溶媒を吹き付け直列に繋 がったセルを印刷して製造される.OPV の性能評価を製 造工程内で行うことができれば,印刷装置の故障の早期 発見,不良品の早期発見によるコスト削減が期待できる. OPV は動いているため信号線やグラウンド接地するこ とが難しく,非接触で計測する必要がある.そこで非接 触電界計測が可能で,金属を用いておらず計測対象に擾 乱を与えにくい EO(:Electro-Optic)プローブを用いて評価 する方法が提唱されるようになった.

#### 2. EO プローブ

EO プローブは電気光学効果[2]とレーザ光を用いて非 接触電界計測を行うことができる.印加する電界の強度 に比例して EO 結晶の複屈折率が変化することにより, 結晶を通過するレーザ光に偏光変化が起きる.偏光度合 を位相差とし電界強度を検出する仕組みである.徒来の 平行型と直交型で異なるのは,図1に示す通り,レーザ 光と電界の交わる向きである.直交型はレーザ光と電界 が直交になっており相互作用長が長いので,平行型より も S/N 比が高くなっている.

EO プローブの構造を図2に示す.LD(:Laser Diode)や PD(:Photo Diode)などの能動部品が制御装置内にあり,計 測対象から離れていることによって,低擾乱を実現して いる. EO 結晶には110カットの ZnTe を用いている. 電界 強度の成分は(X, Y, Z)に分けることができるが, 直交型 EO プローブでは, レーザ光と電界が交わる向きの方向 から Z 成分しか検出することができない.



図1 直交型と平行型



EO プローブを用いた電界計測のためのシステム構成を

図3に示す.



図3 システム構成

#### 3. 基本性能

#### (1) 最小検出電圧

直交型の最小検出電圧を図4に示す. 直交型のS/N比は 65dBであり, 平行型は40dBであったため, 25dB向上した.



#### (2) 周波数特性

#### a) 実測

周波数特性の結果を図5に示す.周波数帯域は20Hz~ 1MHz となっている.



高域側を制限しているのは受光回路の差動アンプの帯域 で、低域側を制限しているのは受光回路のキャパシタが 低域側で抵抗のように振る舞うからである.

#### b) 回路シミュレーション

回路シミュレータ LTspice を用いて周波数特性を検証 する.図6に示す回路モデルはコントロールユニットに 配置されている受光回路と同一のもので,PD部分はシミ ュレータにあらかじめ用意されている部品を使わず,PD 等価回路を用いることで内部の動作に不明瞭な点がない よう工夫した.



図6回路モデル

受光回路の簡略化したものを図7に示す.受光回路 は利得が800倍となるよう設計されている.



図7 簡略化した受光回路

得られたシミュレーション結果を図8に示す.



シミュレーションにおける受光回路の周波数帯域は 3Hz~800kHz となっていた.また、Vout/Vin は最大 58dB の利得となっており、これは 794 倍の増幅であるので、 受光回路の設計上の増幅度と一致する.

#### 4. 横方向距離依存性

#### (1) 実測

マイクロストリップ線路の中央を0mm, ZnTeの横方向 の距離をxとして x=-2.5~2.5mm まで0.5mm 間隔で移動 させたときの電界分布を図9に示す. x=0.0~2.5mm で電 圧が高くなり,本来対称になるはずのグラフが非対称に なった.



図 9 横方向依存性

#### (2) 電磁界シミュレーション

FDTD(:Finite-difference time-domain method)と呼ばれる 方法を用いて横方向距離依存性を検証する. FDTD では モデルを含む解析領域を微小直方体に分割し,全セルに おいてマクスウェル方程式[3]を電界と磁界交互に解い ていく[4].

図9が非対称になったのは、ZnTe が付いているガラス が原因と考え、ガラスなし、片側ガラスあり、両側ガラ スありの3パターンについてシミュレーションを行った. 横方向依存性の実験と同様に ZnTe を x=-2.5~2.5mm ま で0.5mm間隔で移動させ、ZnTe 中央のZ成分の電界をプ ロットした.ガラスなしを図10、片側ガラスありを図11、 両側ガラスありを図12 に示す.





図10~12を確認すると、ガラスなしと両側ガラスあり ではグラフが対称になっていた.片側ガラスありのとき の電界分布は図11に示す通りガラスのあるほうで電圧 値が強くなっている.よって、グラフが非対称である原 因はガラスにあると考えられる.



図10 片側にガラスがあるときの電界

#### 5. 結論

本研究は直交型 EO プローブのレーザ光と電界の交わ る向きが垂直になるよう工夫したことにより,平行型よ りも S/N 比が 25dB 向上したことを示した.また,基本性 能で得られた横方向依存性では,対称になるはずのグラ フが非対称になっていたことに着目し,FDTD を用いて 検証した結果, ZnTe が付いているガラスの影響を受けて 電界が乱れていることが判明した.対策としてはガラス を両側に取り付けて左右対称な構造とすればよいと考え られる.今後は直交型 EO プローブを製品化させるため に,計測の高速化が必要と言える.高速化のためには OPV のセル1点の計測時間を短くできるよう,さらなる 高感度化が必要である.

#### 参考文献

- S. Logothetidis, "Flexible organic electronic devices: Materials, process and applications," Mater. Sci. Eng. B, Vol.152, No.1-3, pp.96-104, 2008.
- [2] F.Pockels, Lehrbuch der Kritalloptic, Leipzig: Teubner, 1906.
- [3] 砂川重信, "電磁気学の考え方," 岩波文庫, 1993.
- [4] 宇野亨, FDTD 法による電磁界およびアンテナ解析, コロナ社, 1998.